

装置番号	施設名称	試料寸法	設置場所	装置分類	共用施設等 使用料	技術指導 等費
					(円/時間)	(円/時間)
MEMS001	ウェハデripp洗浄装置	200/300 mm	TKB812-F	処理	10,000	12,000
MEMS002	ウェハスピ洗浄装置	200/300 mm	TKB812-F	処理	10,000	12,000
MEMS003	有機ドラフト	300 mm以下	TKB812-F	処理	10,000	12,000
MEMS004	異方性ウェットエッチング装置	200 mm	TKB812-F	加工	18,000	12,000
MEMS005	IPAペーパー乾燥機	200 mm	TKB812-F	処理	10,000	12,000
MEMS006	i-線ステツパ	200 mm	TKB812-F	加工	29,000	12,000
MEMS007	マスク露光装置	200 mm	TKB812-F	加工	18,000	12,000
MEMS008	マスクレス露光装置	500 mm角以下	TKB812-F	加工	18,000	12,000
MEMS010	光学顕微鏡(注1)	300 mm以下	TKB812-F	分析・評価	10,000	12,000
MEMS011	Si酸化膜プラズマCVD装置	200 / 300 mm	TKB812-F	加工	21,000	12,000
MEMS012	スパッタ	200 mm	TKB812-B	加工	21,000	12,000
MEMS013	酸化炉	200 mm	TKB812-F	加工	21,000	12,000
MEMS015	Si窒化膜減圧CVD装置	200 mm	TKB812-F	加工	21,000	12,000
MEMS016	ポリSi減圧CVD装置	200 mm	TKB812-F	加工	21,000	12,000
MEMS017	金属膜ドライエッチング装置	200 mm	TKB812-F	加工	21,000	12,000
MEMS018	Si酸化膜ドライエッチング装置	200 mm	TKB812-F	加工	18,000	12,000
MEMS019	8"Si深掘ドライエッチング装置	200 mm	TKB812-F	加工	21,000	12,000
MEMS020	12"Si深掘ドライエッチング装置	300 mm	TKB812-F	加工	29,000	12,000
MEMS021	犠牲層ドライエッチング装置	100 / 150 / 200 mm	TKB812-F	加工	20,000	12,000
MEMS022	アッシャー	300 mm以下	TKB812-F	加工	10,000	12,000
MEMS023	光学検査顕微鏡(注2)	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	18,000	12,000
MEMS024	段差測定器	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	18,000	12,000
MEMS025	エリブソメーター(注2)	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	18,000	12,000
MEMS026	膜厚測定器(注2)	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	18,000	12,000
MEMS027	ウェハ塵埃検査装置	200 mm	TKB812-F	分析・評価	18,000	12,000
MEMS028	干渉型表面形状評価装置(注2)	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	18,000	12,000
MEMS029	シート抵抗プローバー(注2)	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	18,000	12,000
MEMS030	赤外線レーザ顕微鏡(注2)	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	18,000	12,000
MEMS031	レーザ顕微鏡(注2)	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	18,000	12,000
MEMS032	ブレードダイサー	300 mm以下	2A-CR	加工	18,000	12,000
MEMS033	レーザステルスダイサー	200 mm以下	2A-CR	加工	21,000	12,000
MEMS034	光学顕微鏡(注1)	300 mm以下	2A-CR	分析・評価	10,000	12,000
MEMS036	電子ビーム/抵抗蒸着装置	200 mm	TKB812-B	加工	18,000	12,000
MEMS037	熱処理装置	200 mm	TKB812-B	加工	18,000	12,000
MEMS038	チップtoウェハ接合装置	100 / 150 / 200 / 300 mm	TKB812-B	加工	21,000	12,000
MEMS039	ウェハtoウェハ接合装置	100 / 150 / 200 mm	TKB812-B	加工	21,000	12,000
MEMS041	光表面処理装置	200 mm	TKB812-B	処理	18,000	12,000
MEMS042	12"ウェハ常温接合装置	100 / 150 / 200 / 300 mm	3F-CR	加工	21,000	12,000
MEMS043	測長SEM	200 mm	TKB812-B	分析・評価	21,000	12,000
MEMS044	分析SEM	300 mm以下	TKB812-B	分析・評価	10,000	12,000
MEMS045	超音波顕微鏡(注2)	300 mm以下	TKB812-B	分析・評価	18,000	12,000
MEMS046	赤外線顕微鏡(注2)	200 mm以下	TKB812-B	分析・評価	18,000	12,000
MEMS047	薄膜応力評価装置(注2)	100/125/150/200 mm	TKB812-B	分析・評価	18,000	12,000
MEMS048	X線CT評価装置	300 mm以下	TKB812-B	分析・評価	21,000	12,000
MEMS049	テスタープローバー	200 mm以下	TKB812-B	分析・評価	18,000	12,000
MEMS050	光学顕微鏡(注1)	300 mm以下	TKB812-B	分析・評価	10,000	12,000
MEMS051	圧電定数評価装置	100-200mm	3H-CR	分析・評価	20,000	12,000
MEMS053	ダイシエアテスタ	100 mm以下	TKB812-B	分析・評価	18,000	12,000
MEMS058	無機ドラフト	300mm以下	TKB812-F	処理	10,000	12,000
MEMS059	レジスト塗布現像装置	200 mm	TKB812-F	分析・評価	18,000	12,000
MEMS060	イオンミリング装置	200mm以下	TKB812-B	加工	21,000	12,000
MEMS069	自動光学顕微鏡(注2)	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	10,000	12,000
MEMS070	レーザードップラー測定器	200mm以下	TKB812-B	分析・評価	18,000	12,000
MEMS071	フーリエ変換赤外分光装置	200 mm以下	TKB812-F	分析・評価	18,000	12,000
MEMS072	小口径スパッタ	100 mm以下	TKB812-B	分析・評価	18,000	12,000
MEMS073	マニュアルプローバ	200 mm以下	TKB812-B	分析・評価	18,000	12,000
MEMS074	ダイシングフィルム貼付装置(注2)	200 mm以下	2A-CR	加工	10,000	12,000
MEMS075	保護フィルム貼付装置(注2)	200 mm以下	TKB812-F	加工	10,000	12,000
MEMS076	フォトリソ工程用オープン(注2)	200mm以下	TKB812-F	加工	10,000	12,000
MEMS077	2流体洗浄装置(注2)	200 mm以下	3F-CR	処理	10,000	12,000

装置番号	施設名称	試料寸法	設置場所	装置分類	共用施設等 使用料	技術指導 等費
					(円/時間)	(円/時間)
MEMS078	リフトオフ装置	200 mm以下	TKB812-F	加工	21,000	12,000
MEMS079	レーザーマーカ	200 mm以下	TKB812-F	加工	18,000	12,000
MEMS080	チップソーター	200 mm以下	TKB812-B	加工	10,000	12,000
MEMS081	高速シリコン深掘り装置	200 mm以下	2E-CR	加工	22,000	12,000(注4)
MEMS082	高速酸化膜ICPエッチング装置	200 mm以下	2E-CR	加工	20,000	12,000(注4)
MEMS083	金属膜ICPエッチング装置	200 mm以下	2E-CR	加工	22,000	12,000(注4)
MEMS084	汎用RIE装置	200 mm以下	2E-CR	加工	10,000	12,000(注4)
MEMS085	低温対応酸化膜・窒化膜CVD装置	200 mm以下	2E-CR	加工	22,000	12,000(注4)
MEMS086	高荷重フリップチップボンダー	100 mm角以下	2E-CR	加工	10,000	12,000(注4)
MEMS087	ピコ秒レーザー加工機	200 mm角以下	2E-CR	加工	10,000	12,000(注4)
MEMS088	イナートオープン	200 mm角以下	2E-CR	処理	6,000	12,000(注4)
MEMS089	酸素プラズマバレル型アッシャー	150 mm以下	2E-CR	加工	10,000	12,000(注4)
MEMS090	水蒸気プラズマ対応アッシャー	200 mm角以下	2E-CR	加工	10,000	12,000(注4)
MEMS091	両面スクラブ・二流体・メガソニックウエハ洗浄装置	200 mm以下	2E-CR	処理	8,000	12,000(注4)
MEMS092	高解像度4Kデジタルマイクロスコープ	300 mm以下	2E-CR	分析・評価	1,000	12,000(注4)
MEMS093	裏面対応高速レーザー直描装置	200 mm角以下	2E-CR	加工	20,000	12,000(注4)
MEMS094	裏面対応コンタクトアライナ	100 mm以下	2E-CR	加工	10,000	12,000(注4)
MEMS095	青色レーザー顕微鏡	300 mm以下	2E-CR	分析・評価	2,000	12,000(注4)
MEMS096	セミオートコーター・デベロッパ	200 mm以下	2E-CR	加工	10,000	12,000(注4)
MEMS097	HMD5処理装置	200 mm以下	2E-CR	処理	3,000	12,000(注4)
MEMS098	スプレーコーター	200 mm角以下	2E-CR	加工	5,000	12,000(注4)
MEMS099	光学干渉式膜厚計	300 mm以下	2E-CR	分析・評価	2,000	12,000(注4)
MEMS100	触針式段差計	100 mm以下	2E-CR	分析・評価	1,000	12,000(注4)
MEMS101	電界放出形電子顕微鏡	100 mm以下	2E-CR	分析・評価	18,000	12,000(注4)
MEMS102	冷却イオンミリング装置	小片	2E-CR	加工	1,000	12,000(注4)
MEMS103	オスミウムコーター	100 mm以下	2E-CR	加工	1,000	12,000(注4)
MEMS104	マニュアルヘキ開装置	200 mm以下	2E-CR	加工	500	12,000(注4)
MEMS105	赤外線顕微鏡	100 mm以下	2E-CR	分析・評価	2,000	12,000(注4)
MEMS106	マニュアルボールボンダー	小片	2E-CR	加工	500	12,000(注4)
MEMS107	マニュアルウェッジワイヤーボンダー	小片	2E-CR	加工	500	12,000(注4)
MEMS108	マニュアルダイボンダー	小片	2E-CR	加工	500	12,000(注4)
MEMS109	25MHz3次元レーザードップラー振動計	200 mm角以下	2E-CR	分析・評価	5,000	12,000(注4)
MEMS110	白色干渉式形状観察装置	200 mm角以下	2E-CR	分析・評価	5,000	12,000(注4)
MEMS111	半導体パラメータアナライザ	—	2E-CR	分析・評価	1,000	12,000(注4)
MEMS112	バリレンコーター	200 mm角以下	2E-CR	加工	5,000	12,000(注4)
MEMS113	膜応力測定装置	200 mm以下	2E-CR	分析・評価	1,000	12,000(注4)

装置番号:MEMS研究開発拠点で装置管理のために使用している番号

設置場所:装置が設置してある部屋

装置分類:装置の利用目的や原理に応じて分類された区分

(注1)「MEMS010」「MEMS034」「MEMS050」以外の装置との併用の場合は無料

(注2)18,000円/時以上の装置との併用の場合は無料

(注3)オペレーターによる技術代行のみ(共用施設利用料+技術指導等費)

(注4)装置トレーニングは5,000円/時

※この単価表に記載した金額に消費税及び運営管理費等は含まれておりません。消費税等により生じた小数点以下の端数については切捨てて処理致します。

利用料等についての補足

◇追加料金

追加的に必要な作業等が発生した場合に徴収する以下に記載の料金(共用施設等利用約款(第6条第1項第5号))

ア 改造費:共用施設等を改造するために必要な費用で、具体的な改造工事の内容により実費相当額を算定して積算した額

イ 復元費:改造又は変造した共用施設等を原状復帰させるために必要な費用で、具体的な復元工事の内容により実費相当額を算定して積算した額

ウ 他の共用施設等の利用に係る経費:共用施設利用約款第3条第2項の規定により利用契約が成立した共用施設等の利用目的の達成に資するために、当該共用施設等以外の共用施設等を用いる場合の共用施設等使用料並びに研究所の役職員等による操作、運転、技術指導及び技術代行等が追加的に必要な場合の費用の額

エ 研究所以外の機関の施設等の利用に関する経費:共用施設利用約款第3条第2項の規定により利用契約が成立した共用施設等の利用目的の達成に資するために、研究所以外の第三者機関(民間企業を含む。以下同じ。)の施設等を用いる場合の施設利用料並びに当該第三者機関の役職員等による操作、運転、技術指導及び技術代行等が追加的に必要な場合の費用の額

オ 上記エの場合における研究所の役職員等の従事に要する経費:上記エの場合における研究所の役職員等による操作、運転、観察、分析、解析、加工、試料作製等が追加的に必要な場合の費用の額

カ その他実費:共用施設等の利用に際し、研究所において追加的な購入が必要となる器具、材料、薬品その他の消耗品及び第三者機関へ外注する評価、分析、技術代行その他の業務であって、あらかじめ研究所と利用者が費用負担について合意した費用の額

◇運営管理費(第6条第1項第6号):

利用料金(共用施設等使用料、運転費、技術指導費、技術代行業、追加料金の合計)額に15パーセントを乗じた額